(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2008 年5 月2 日 (02.05.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/050785 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/42 (2006.01) *H01L 21/3213* (2006.01)
H01L 21/027 (2006.01) *H01L 21/768* (2006.01)
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/070691

(22) 国際出願日: 2007 年10 月24 日 (24.10.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2006-289113
2006 年10 月24 日 (24.10.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 関東化学株式会社 (KANTO KAGAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1030023 東京都中央区日本橋本町３丁目２番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大和田 拓央 (OHWADA, Takuo) [JP/JP]; 〒3400003 埼玉県草加市稲荷１－７－１ 関東化学株式会社中央研究所内 Saitama (JP).

(74) 代理人: 葛和 清司, 外(KUZUWA, Kiyoshi et al.); 〒1620067 東京都新宿区富久町８番２１号 Ｔ＆Ｔビル 葛和国際特許事務所 Tokyo (JP).

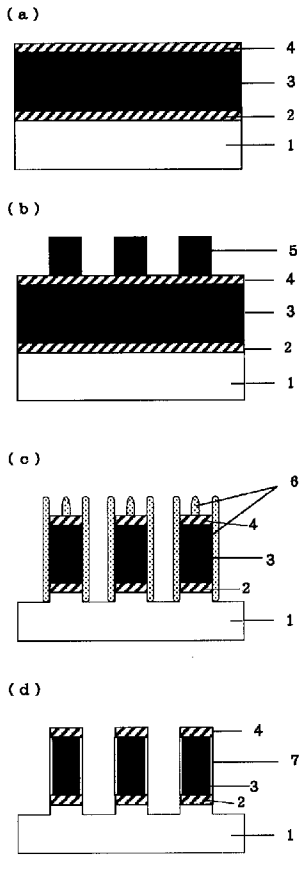
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

[続葉有]

(54) **Title:** LIQUID COMPOSITION FOR REMOVING PHOTORESIST RESIDUE AND POLYMER RESIDUE

(54) 発明の名称: フォトレジスト残渣及びポリマー残渣除去液組成物



(57) **Abstract:** Provided is a liquid composition for, at a low temperature in a short time, removing a photoresist residue and a polymer residue generated in a semiconductor circuit element manufacturing process. A residue removing method using such composition is also provided. The composition removes the photoresist residue and/or the polymer residue generated in the manufacturing process of a semiconductor circuit element having a metal wiring. The composition includes a fluorine compound of 0.5-3.0 mass% and water not over 30 mass%, and has a pH of 4 or less.

(57) 要約: 半導体回路素子の製造工程において生じるフォトレジスト残渣及びポリマー残渣を低温、短時間で除去するフォトレジスト残渣及びポリマー残渣除去液組成物、並びにそれを用いた残渣の除去方法を提供する。本発明は、金属配線を有する半導体回路素子の製造工程において生じるフォトレジスト残渣及び／又はポリマー残渣を除去する組成物であって、フッ素化合物を０．５～３．０質量%および水を３０質量%超えない量含み、ｐＨが４以下である、前記組成物である。

WO 2008/050785 A1

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書